

性能特点

- 高精度 MEMS 微纳米加工
- 高性能、高一致性微型 MEMS 滤波器
- 硅基片、50 Ω 共面波导输出
- 金丝键合,适用于多芯片集成模块应用

环境参数

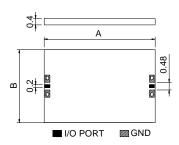
工作温度	-55℃~+85℃		
存储温度	-55℃~+125℃		
最高输入功率	35dBm		

电特性(T_A=+25℃)

项目	最小值	典型值	最大值	单位
中心频率(f ₀)	-	9.4	-	GHz
通带频率范围	8.7	-	10.1	GHz
带内波动	-	-	1	dB
中心插损	-	-	2.8	dB
回波损耗	15	-	-	dB
	≥30@8.08GHz&10.86GHz			dB
一 一带外衰减	≥40@7.84GHz&10.92GHz		dB	
市外表观	≥60@DC~7.23GHz			dB
	≥60@13.3~19.4GHz			dB
时延波动	≤1.2@8.7	ns		
线性相位	≤±6@8.7	۰		

S2P 文件名: SiMS9R4_1R4-12D2.s2p

外形尺寸



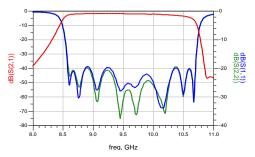
尺寸符号	数值(mm)			
ハッケラ	最小值	公称值	最大值	
Α	8.9	-	9.0	
В	3.9	-	4.0	

典型测试曲线

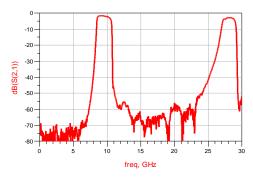
通带损耗 VS 频率(T_A=25℃)



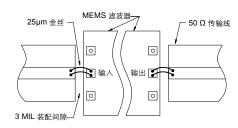
带外抑制 & 回波损耗 VS 频率(TA=25℃)



远端抑制 VS 频率(T_A=25℃)

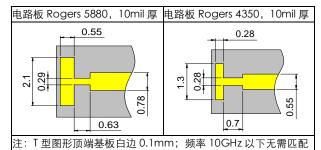


建议装配图



注意事项:

- 1. 芯片建议分腔使用,两侧距侧壁 0.2mm,表面距上 盖 3mm,芯片端口可互换;
- 2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接;
- 3. 芯片应安装在可伐(推荐)或钼铜等与硅热膨胀系数 (2.9ppm/℃)相当的载体上,载体厚度≥0.2mm;
- 4. 电路板微带线与芯片键合连接时,建议微带线键合 处采用「型结构进行匹配,「型尺寸如下:



5. 有问题请与供货商联系。

